

# 2SC2464

シリコン NPN エピタキシャル 形

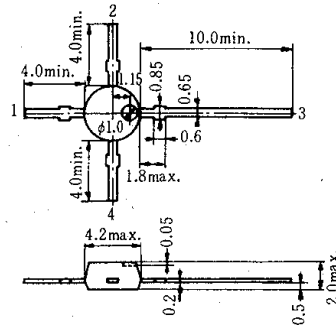
UHF 高周波増幅用

UHF TV チューナ高周波増幅用

SILICON NPN EPITAXIAL

UHF AMPLIFIER

UHF TV TUNER RF AMPLIFIER



1. エミッタ: Emitter
2. ベース: Base
3. コレクタ: Collector
4. ベース: Base

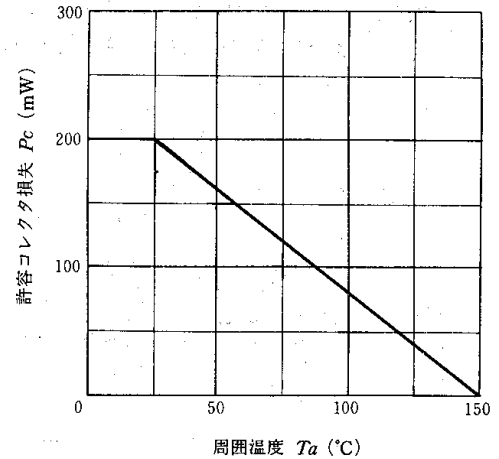
(Dimensions in mm)

(FPAK)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	2SC2464	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	25	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	4	V
コレクタ電流	$I_C$	20	mA
許容コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	30	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	25	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	4	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=3\text{mA}$	30	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	5.0	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=3\text{mA}$	750	900	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	0.55	0.8	pF
電力利得	$PG$	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=3\text{mA}, f=900\text{MHz}$	14	16	—	dB
雑音指数	$NF$	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=3\text{mA}, f=900\text{MHz}$	—	4.0	6.0	dB
AGC電圧	$V_{AGC}$	$V_{CB}=10\text{V}, GR=30\text{dB}, f=900\text{MHz}$	3.5	—	4.8	V